

عنوان مقاله:

بررسی ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله ی کربنی تک جداره و چندجداره

محل انتشار:

اولین همایش منطقه ای مهندسی برق (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسنده:

فخرالسادات رستگاری - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

خلاصه مقاله:

از زمانی که اولین گزارشها در مورد نانو لوله های کربنی در سال 1993 ارائه شد آنها موضوعی جذاب برای تحقیقات اساسی و کاربردی بوده اند از جمله مباحثی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته مبحث ترانزیستور های اثر میدان نانولوله ی کربنی می باشد زمانی که اولین ترانزیستور اثر میدان نانولوله ی کربنی در سال 1993 گزارش شد چگونگی عملکرد این قطعه خیلی واضح نبود اما با پیشرفتهای بعدی شناخت تکنولوژی آن را با سرعت بسیاری انجام شد در این مقاله ترانزیستورهای اثر میدان ساخته شده با استفاده از نانولوله های کربنی تک جداره و چند جداره مورد بررسی قرار میگیرند.

کلمات کلیدی:

ترانزیستور اثر میدان، تکجداره، چند جداره، نانولوله ی کربنی ، CNFET

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/96554>

